esp@cenet document view

Light weight structure

Patent number:

DE19837768

Publication date:

2000-03-09

Inventor:

GOEDTKE PETER (DE); KROEDEL MATTHIAS (DE);

PAPENBURG ULRICH (DE)

Applicant:

ECM INGENIEUR UNTERNEHMEN FUER (DE);;

INDUSTRIEANLAGEN BETRIEBSGES (DE)

Classification:

- International:

C04B35/80

- european:

C04B35/80D; C04B37/00B

Application number: DE19981037768 19980820 Priority number(s): DE19981037768 19980820

Report a data error here

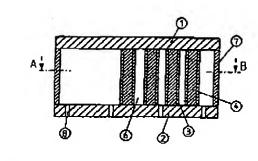
Also published as:

EP0987096 (A2)

EP0987096 (A3)

Abstract not available for DE19837768
Abstract of corresponding document: EP0987096

A lightweight monolithic structure, comprises front and back plates (1, 2) and a support framework (3) of carbon fiber-reinforced silicon carbide or carbon (C/SiC or C/C) ceramic bonded or mechanically joined together. An Independent claim is also included for production of the above lightweight structure, in which the support framework (3) is adhesive bonded between the front plate (1) and back plate (2) using a synthetic resin and the assembly is infiltrated with molten silicon which reacts with part of the carbon to form silicon carbide and produce a rigid permanently bonded monolithic structure.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Offenlegungsschrift ® DE 198 37 768 A 1

198 37 768.1 (1) Aktenzeichen: ② Anmeldetag:

(3) Offenlegungstag:

20. 8, 1998

(f) Int. Cl.⁷: C 04 B 35/80

9. 3.2000

(7) Anmelder:

ECM Ingenieur-Unternehmen für Energie- und Umwelttechnik GmbH, 81539 München, DE; Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH, 85521 Ottobrunn, DE

(7) Erfinder:

Goedtke, Peter, 81687 München, DE; Krödel, Matthias, 85521 Ottobrunn, DE; Papenburg, Ulrich, 85658 Egmeting, DE

Entgegenhaltungen:

DE 196 38 223 A1 30 18 785 A1 DE 11 67 898 GB 11 26 930 GB 36 44 022 US 29 88 959 US 7 35 387 A1 EP

Die folgenden Angeben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantreg gem. § 44 PetG ist gestellt

- (Meß- u. Spanntische, Meßbänke, Führungsschienen und -bahnen, Meschinenbetten u. -tische) insb. für Meß-, Spann- u. Bearbeitungszwecke aus faservertärkter Keramik
- Bei der Herstellung von hochsteifen Leichtgewicht-strukturen werden zur Bildung des Stützgerüsts (3) zwischen einer Frontplatte (1) und einer Rückplatte (2) aus faserverstärkter Keramik rohrförmige und/oder plattenförmige und/oder leistenförmige Teile aus faserverstärktem Kohlenstoff (C/C) oder kohlenstoffeserverstärktem Siliciumcarbid (C/SiC) aufgestellt und mittels Kunstharz verklabt. Die verbleibenden Leerräume beliebiger Geometrie und Größe bilden dabel entsprechende Hohlräume in der Leichtgewichtstruktur aus. Danach wird diese Anordnung In einen Ofen unter Aufrechterhaltung einer nicht oxidierenden Atmosphäre auf mindestens die Schmelztemperatur von Silicium erhitzt, wobei das geschmolzene Silicium in den Werkstoff infiltriert und zumindest teilweise mit dem angebotenen Kohlenstoff zu Siliciumcarbid abreagiert und nach dem Abkühlen das so erhaltene Stützgerüst mit der Front- und Rückplatte unverrückbar miteinander zu einer monolithischenLeichtgewichtstruktur aus feserverstärkter Keramik verbunden ist

LEE POLLING EXA

1

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine hochsteife Leichtgewichtstruktur, insbesondere für Meß-, Spann- und Bearbeitungszwecke, die zwischen einer Frontplatte (1) aus faserverstärkter Keramik und einer Rückplatte (2) aus faserverstärkter Keramik ein mit diesen Platten unverrückbar verbundenes Stützgertist (3) aus faserverstärkter Keramik aufweisen, wobei die jeweils für die Front- und Rückplatten und das Stützgerüst ausgewählten keramischen Verbundwerkstoffe, vorzugsweise kohlenstoffaserverstärkte Kohlenstoffe (C/C) oder kohlenstoffaserverstärktes Siliciumcarbid (C/SiC), gleiche thermische Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, und auf ein Verfahren zur Herstellung einer solchen keramischen Leichtgewichtstruktur in Sandwich-Bauweise mit hoher Steifigkeit. Die Bildung der Verbindung zwischen Frontplatte, Rückplatte und Stützgerüst erfolgt über die Reaktionsinfiltration von flüssigem Silicium in das zuvor geklebte Halbzeug und führt nach der Abkühlung zur Ausbildung einer monolithischen Leichtgewichtstruktur hoher 20 Steifigkeit aus faserverstärkter Keramik, vorzugsweise kohlenstoffaserverstärktes Siliciumcarbid (C/SiC), in Sandwich-Bauweisc

Aus der US-PS 2988959 ist ein Leichtgewichtspiegel in Sandwich-Form bekannt, der aus einer Frontplatte und einer 25 im Abstand zueinander angeordneten Rückplatte besteht, die über im Abstand zueinander angeordnete Rohrstücke unverrückbar miteinander verbunden sind. Die Rohrstücke bilden das Stützgerüst des Spiegels. Als Werkstoffe für die Frontplatte, die Rückplatte und die Rohrstücke wird Glas 30 verwendet. Die Herstellung des Spiegels erfolgt in der Weise, daß die Robretticke mittels eines Bindemittels mit der einen Platte und danach in gleicher Weise mit der anderen Platte verbunden werden. Diese bekannten Spiegel sind einfach in ihrem Aufbau, sie besitzen jedoch eine nicht aus- 35 reichende Steifigkeit gegen Kräfte, die parallel zur Rückplatte wirken. Außerdem zeigen derartige Kleber im Einsatz Formveränderungen durch chemische Veränderungen und Wasseraufnahme. Derartige Bauteile sind somit nicht langzeitstabil.

Bekannt sind aus der GP-PS 11 67 898 Leichtgewichtspiegel, bei denen die Frontplatte und die Rückplatte über ein Stützgerüst miteinander verbunden sind, das entweder aus Rohrstücken besteht oder aus Abstandsgliedern, die im Querschnitt die Form eines Kreuzes aufweisen. Anstelle der 45 genannten Rohrstücke oder Abstandsglieder mit der Form eines Kreuzes im Querschnitt können auch Abstandsglieder verwendet werden, die durch zusammengesteckte Streifen bestehen, die eine Art Tragrost-Konstruktion aufweisen. Die Leichtgewichtspiegel bestehen aus thermisch kristallisiertem Glas (Glaskeramik), das einen SiO2-Gehalt von bis zu 70 Gew.-% aufweist und dessen andere Hauptbestandteile LiO2 und Al2O3 sind. Anstelle dieses thermisch kristalliersierbaren Glases hat man zur Herstellung derartiger Leichtgewichtspiegel auch schon hochsilikatische Gläser (Gläser 55 mit einem SiO2-Gehalt von mindestens 90 Gew.-%, deren thermischer Ausdehnungskoeffizient durch Zugabe von Dotiermitteln, wie beispielsweise TiO2, auf einen Wert eingestellt wird, der dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Quarzglas gleich oder sogar kleiner als dieser ist) ver- 60 wendet. Solche Spiegel sind im Handel (Prospekt "Low Expansion Materials" der Fa. Corning Glass Works, Corning N.Y, USA, 1969). Nachteilig bei diesen Spiegeln ist eine relativ geringe Steifigkeit und Festigkeit von Glas und Glaskeramik sowie die niedrige Wärmeleitfähigkeit, was bei Tem- 65 peraturdifferenzen zu Temperaturinhomogenitäten, hohen thermischen Zeitkonstanten und somit lokalen Verformun2

Zur Verbesserung der Querstabilität sind in der GP-PS 11 26 930 Leichtgewichtspiegel beschrieben, bei denen das Stiltzgerüst aus einer Platte besteht, die mit durchgehenden Bohrungen versehen ist. Als Werkstoff für diese Strukturen wurde für die Spiegelplatte Quarzglas und für das Stützgerilst Quarzgut verwendet. Die Rückplatte besteht dabei ebenfalls aus Quarzglas oder Quarzgut. Nachteilig bei diesem Verfahren ist, daß durch die Verwendung von zwei unterschiedlichen Werkstoffen sogenannte "Bi-Metall-Effekte" innerhalb der Struktur entstehen.

Bekannt sind aus der US-PS 3644022 Leichtgewichtspicgel, bei denen das Stützgerüst aus Y-förmigen Bauelementen gebildet ist, die zu einem honigwabenartigen Stützgerüst hoher Steifigkeit verschweißt sind. Als Werkstoff wurde für diese Struktur siliciumdioxidhaltiges Material verwendet. Die Schweißnähte führen zu entsprechenden Inhomogenitäten in der Struktur.

Die in den letztgenannten Patenten beschriebenen Leichtgewichtspiegel-Ausbildungen besitzen zwar die gewünschte ausreichende Steifigkeit, insbesondere auch Steifigkeit gegnüber parallel zur Rückplatte wirkender Kräfte, jedoch ist ihre Herstellung außerordentlich arbeitsaufwendig und mit großem Risiko in bezug auf eine fehlerfreie Herstellung behaftet. Dies wird deutlich, wenn man bedenkt, daß beim Bohren der Löcher oder beim Verschweißen der das Stützgerüst bildenden Bauteile Sprünge auftreten können.

Aus der DE 30 18 785 G2 ist ein Verfahren zur Herstellung von Leichtgewichtspiegeln bekannt, bei der zwischen einer Frontplatte aus Quarzglas oder hochsilikatischem Glas und einer Rückplatte aus Quarzglas, Quarzgut oder hochsilikatischem Glas ein mit diesen Platten unverrückbar verbundenes Stützgerüst aus Quarzglas, Quarzgut oder hochsilikatischem Glas aufweist, wobei die jeweils für die Platten und das Stützgerüst ausgewählten Werkstoffe gleiche thermische aufweisen. Nachteilig bei diesem Verfahren ist die Verwendung unterschiedlicher Glas-Werkstoffe in Kombination mit Sintermassen anderer Zusammensetzung. Dieses führt zu entsprechenden Struktur-Inhomogenitäten. Außerdem sind Sinterhilfsmittel und darüberhinaus mehrere thermische Behandlungsprozesse notwendig. Ein Großteil der Hohlräume sind mit Sintermasse aufgefüllt, was das Leichtgewicht-Potential wesentlich einschränkt.

Stand der Technik für die zuvor angesprochenen Anwendungen sind auch massive Granit-Platten. Zur Gewichtsreduzierung müssen diese über aufwendige Verfahren und mit speziellen Werkzeugen entsprechend geschliffen werden.

Pulvermetallurgisch hergestellte Keramiken auf der Basis von Aluminiumoxid Siliciumnitrid oder Siliciumcarbid sind aufgrund der erheblichen Schwindung während des Sinterprozesses sowohl in der Bauteilgröße als auch in der minimalen Wandstärke limitient. Stand der Technik sind bisher nur Größen von <700 mm. Größere Strukturen, auch als Vollblock, haben aufgrund der nicht-linearen Schwindung während der Herstellung immer Risse gezeigt.

Demgemäß hat sich die Erfindung die Aufgabe gestellt, Leichtgewichtstrukturen aus faserverstärkter Keramik in einer Art "Sandwich"-Bauweise mit hoher Steifigkeit und Pestigkeit auch beim Auftreten von Querkräften zu schaffen, die einfach und preiswert herzustellen sind und deren Herstellungsverfahren die aufgezeigten Mängel bekannter Herstellungsverfahren für das Stützgerüst nicht aufweisen und darüberhinaus die werkstoffbedingenten Nachteile (niedrige Steifigkeit und Festigkeit sowie Wärmeleitfähigkeit u. a.) der Glas- und Glaskeramik-Werkstoffe durch den Binsatz von faserverstärkten Keramiken ausschaltet. Außerdem sieht das erfindungsgemäße Verfahren die Herstellung der Verbindung zwischen Frontplatte (1), Rückplatte (2) und Stützgerfüst (3) zu einer monolithischen Sandwich-Struktur

3

in nur einem thermischen Behandlungsschritt und ohne Sinterhilfsmittel vor. Damit besteht die monolithische Leichtgewichtstruktur aus faserverstärkter Keramik im Vergleich zum Stand der Technik insgesamt nur aus einem homogenen Werkstoff mit gleichen physikalischen Eigenschaften.

Gelöst wird diese Aufgabe für eine Leichtgewichtstruktur der eingangs charakterisierten Art erfindungsgemäß dadurch, daß das Stützgerüst (3) aus plattenformigen und/oder leistenförmigen und/oder rohrförmigen und/oder T-förmigen und/oder U-förmigen und/oder T-förmigen und/oder Y- 10 förmigen Teilen besteht, die mittels eines Kunstharzes unverrückbar untereinander, einen Hohlraum bildend, verbunden sind, wobei die Front- (1) und Rückplatte (2) einerseits aus dem gleichen Werkstoff wie die platten- und/oder leisten- und/oder rohrförmigen und/oder T-förmigen und/oder 15 U-förmigen und/oder T-förmigen und/oder Y-förmigen Teile der Stützstruktur (3) besteht und andererseits der Kunstharz bei der thermischen Behandlung bzw. Infiltration des geklebten Sandwich-Halbzeugs mit Silicium zu einer monolithischen Struktur ebenfalls zum gleichen Werkstoff, 20 vorzugsweise faserverstärkter Keramik, abreagiert. Durch die Reaktionsinfiltration des geklebten Halbzeuges mit geschmolzenem Silicium kommt es zur Herstellung der homogenen Verbindung zwischen Prontplatte, Rückplatte und dem Stützgerüst und dem entsprechend zur Bildung einer 25 monolithischen Leichtgewichtstruktur aus kohlenstoffaserverstärktem Siliciumcarbid (C/SiC).

Weitere vorteilhafte Merkmale der erfindungsgemäßen Leichtgewichtstruktur ergeben sich aus den Unteransprüchen und in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen

Es wurde gefunden, daß faserverstärkte Keramiken auf der Basis von C/SiC und C/C über hervorragende Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften, ein hohe Wärmeleitung, eine niedrige Wärmeausdehnung, ausgezeichnete Kor- 35 rosionsbeständigkeit, eine hohe Härte und damit Verschleißbeständigkeit in Kombination mit einer niedrigen Dichte verfügen. Dabei ist es absolut gas- und flüssigkeitsdicht. Darüberhinaus sind faserverstärkte Keramiken im Vergleich zu Glas, Glaskeramiken und pulvermetallurgisch hergestell- 40 ten Keramiken sehr schadenstolerant und bruchunempfindlich. Besonders hervorzuheben sind die große Geometrieund Formenvielfalt bis zu Durchmessern von drei Metern. Erfindungsgemäß kann das C/SiC und C/C mit kontinuierlicher Faserverstärkung, mit Filz- oder Vliesverstärkung oder 45 mit Kurzfaserverstärkung auf der Basis von Kohlenstoffaseru verstärkt sein. Verstärkungen mit anderen thermisch stabilen Fasern sind im erfindungsgemäßen Gedanken miterfaßt.

Das Verfahren zur Herstellung erfindungsgemäßer hoch- 50 steifer Leichtgewichtstrukturen ist dadurch gekennzeichnet, daß zur Bildung des Stützgerüsts (3) zwischen einer Frontplatte (1) und einer Rückplatte (2) leistenförmige und/oder rohrförmige und/oder plattenförmige und/oder T-förmige und/oder U-förmige und/oder T-förmige und/oder Y-för- SS mige Teile aus faserverstärkter Keramik, vorzugsweise kohlenstoffaserverstärkter Kohlenstoff (C/C) oder kohlenstofffascrverstärktes Siliciumcarbid (C/SiC), aufgestellt und mittels Kunstharz verklebt, die verbleibenden Leerräume entsprechende Hohlräume ausbilden und danach diese Anordnung in einen Ofen unter Aufrechterhaltung einer nicht oxidierenden Atmosphäre, vorzugsweise Vakuum, auf mindestens die Schmelztemperatur von Silicium (>1405°C) erhitzt, daß geschmolzene Silicium in den Werkstoff infiltriert bzw. penetrien und zumindest teilweise mit dem angebote- 65 nen Kohlenstoff der Matrix und der Fasern zu Siliciumcarbid abreagiert und nach dem Abkühlen das so erhaltene miteinander zu einer manalithi4

schen Leichtgewichtstruktur aus C/SiC verbunden ist. Die Silicium-Infiltration mit der damit verbundenen SiC-Reaktion dient zum einen zur Verdichtung des Strukturwerkstoffs und zum anderen zur Fügung der Einzelsegmente zu einer 5 monolithischen Leichtgewichtstruktur. Der beim Zusammenbau der Einzelkomponenten verwendete Kunstharz, vorzugsweise auf Phenolharzbasis mit SiC- und/oder Cund/oder Si-Pulveranreicherungen und/oder Kohlenstoffasern, reagiert vorteilhasterweise bei der thermischen Behandlung vor Erreichen der Schmelztemperatur von Silicium (1405°C) zu einem Kohlenstoff-Silicium-Siliciumcarbid-Mischwerkstoff ab, der eine ähnliche Zusammensetzung wie die verwendeten Strukturelemente hat, sodaß die chemaligen Füge- bzw. Klebeflächen nach der Silicium-Infiltration die gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie der Strukturwerkstoff aus faserverstärkter Keramik aufweist. Es kommt durch die Silicium-Infiltration zur Bildung einer monolithischen Struktur mit absolut homogenen Eigenschaften. Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor, daß das zur Infiltration/Reaktion verwendete Silicium den zu infiltrierenden Bauteilen pulverförmig und/oder in Granulatform und/oder als Silicium-Formkörper angeboten wird. Dabei kann crfindungsgemäß das jewcils verwendete Silicium von unten und/oder von oben und/oder im Inneren des zu infiltrierenden Bauteils angeboten werden.

Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens ergeben sich aus den Verfahrensunteransprüchen. Anhand der Fig. 1 bis 6 werden erfindungsgemäße hochsteife Leichtgewichtstrukturen und deren Herstellung beschrieben. Bs zeigt

Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch eine erfindungsgemäße hochsteifen Leichtgewichtstruktur.

Fig. 2 einen Horizontalschnitt durch das Stützgerüst der hochsteifen Leichtgewichtstruktur nach Fig. 1 entlang der Phene A-B.

Fig. 3 einen Vertikalschnitt durch eine Anordnung zur Herstellung einer erfindungsgemäßen hochsteifen Leichtgewichtstruktur.

Fig. 4 einen Ausschnitt eines Horizontalschnitts durch die Anordnung nach Fig. 3 in der Ebene C-D.

Fig. 5 entsprechende Vertikalschnitte durch Anordnungen zur Herstellung von erfindungsgemäßen hochsteifen Leichtgewichtstrukturen.

Fig. 6 die Draufsicht auf eine Anordnung zur Herstellung einer erfindungsgemäßen hochsteifen Leichtgewichtstruk-

Wie aus der Fig. 1 ersichtlich, besteht die erfindungsgemäße hochsteife Leichtgewichtstruktur aus einer Frontplatte (1) und einer Rückplatte (2), die über ein Stützgerüst (3) unverrückbar miteinander verbunden sind. Das Stützgerüst besteht, wie aus Fig. 2 hervorgeht, aus rohrförmigen Teilen (4), die mittels eines Kunstharzes vor der thermischen Behandlung mit der Front- und Rückplatte verhunden sind und einen Hohlraum (6) bilden, um das Gewicht der Leichtgewichtstruktur möglichst gering zu halten. Im Anschluß daran wird dann das aus Frontplatte (1), Rückplatte (2) und Stützgerüst bestehende Halbzeug in einem Ofen unter Sauerstoffausschluß, vorzugsweise Vakuum, auf mindestens die Schmelztemperatur von Silicium (>1405°C) erhitzt. Das geschmolzene Silicium infiltriert bzw. penetriert dann in die Gesamtanordnung und reagiert zumindest teilweise mit dem angebotenen Kohlenstoff zu Siliciumcarbid ab. Diese Siliciuminfiltration bzw. Reaktion dient auch zur Herstellung der Verbindung zwischen Front- und Rückplatte sowie dem Stützgerüst (3) zu einer monolithischen Struktur. Der Querschnitt und die Größe des Hohlraums (6) kann erfindungsgemäß kann je nach Anwendung beliebig (z. B. rund, violekkig, secheckig) sein und ist ersindungsmäßig miterfaßt. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, die Rückplatte (2) oder

6

die Seitenwände (7) mit Entlüftungsbohrungen (8), wie aus Fig. 1 ersichtlich, zu versehen. In dem Ausführungsbeispiel ist die Frontplatte (1), die Rückplatte (2) und das Stützgerüst (3) aus kurzfaserverstärktem C/SiC hergestellt. In analoger Weise können als Werkstoff für die Front- und Rückplatte sowie die rohrförmigen oder plattenförmigen Teile des Stützgerüsts auch C/C-Verbundwerkstoffe mit Kurzfaserund/oder Filz- und/oder Vlies-Verstärkung oder faserverstärkter Keramiken mit kontinuierlicher Faserverstärkung auf der Basis von C/C und C/SiC verwendet werden.

Anhand der Fig. 3 und 4 wird nachfolgend eine zweite Möglichkeit zur Bildung einer hochsteifen Leichtgewichtstruktur aus faserverstärkter Keramik beschrieben. Anstelle der rohrförmigen Teile sind bei diesem Ausführungsbeispiel für die Herstellung des Stützgerüsts (3) platten- bzw- lei- 15 stenförmige Teile aus faserverstärkter Keramik (C/C und/ oder C/SiC) zwischen die Front- und Rückplatte aus faserverstärkter Keramik (C/C und/oder C/SiC) aufgestellt und verklebt worden. Nach Verbinden des so hergestellten Stützgerüsts (3) mit der Frontplatte (1) und der Rückplatte (2) 20 entsteht dann, wie im Zusammenhang in Fig. 1 und 2 beschrieben, durch die Infiltration mit flüssigem Silicium sowie die Reaktion zu Siliciumcarbid eine hochsteife Leichtgewichtstruktur in monolithischer Bauweise. Dabei kann der Querschnitt des platten-/leistenförmigen Stützgerüsts, 25 die Abstände zwischen den Leisten und die Winkelanordnung der Stützleisten beliebig variieren. Das erfinderische Verfahren sicht auch eine Kombination von rohrförmigen und leistenförmigen und plattenförmigen Stützstrukturen zwischen Front- und Rückplatte vor. Selbstverständlich 30 können die Front- und Rückplatte sowohl plan als auch sphärisch ausgebildet sein. Die Stützkonstruktion muß dann vor dem Zusammenbau zum Halbzeug bzw. vor der Infilmation zum keramischen monolithischen Bauteil entsprechend mechanisch bearbeitet werden.

In Fig. 5 sind entsprechende Vertikalschnitte durch mögliche Anordnungen zur Herstellung von erfindungsgemäßen- hochsteifen Leichtgewichtstrukturen mit einem U-förmigen, Y-förmigen, T-förmigen und T-förmigen Stützgerüst (3) zwischen Front(1) und Rückplatte (2) abgebildet.

Fig. 6 zeigt die Draufsicht auf eine -Anordnung zur Herstellung einer erfindungsgemäßen hochsteifen Leichtgewichtstruktur mit zylinderförmigem Stützgerüst (3) zwischen der Front- (1) und Rückplatte (2). Diese hochsteife Leichtgewichtstruktur aus faserverstärkter Keramik in monolithischer Sandwich-Bauweise mit den Abmessungen $1200 \times 1100 \times 60 \text{ mm}^3$ dient beispielsweise als Laser-Meßtisch.

Wie sich aus den Figurenbeschreibungen ergibt, läßt sich das Stützgerüst von erfindungsgemäßen hochsteifen Leichtsgewichtstrukturen und damit die Leichtgewichtstruktur selbst in einfacher Weise und aus einfachen Bauteilen und damit preiswert herstellen, ohne daß bei der Herstellung des Stützgerüsts Risse auftreten können.

Patentansprüche

1. Leichtgewichtstrukturen mit einer Frontplatte (1), einer Rückplatte (2) und einem Stützgerüst (3), wobei diese Teile aus keramischem Material bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß die Frontplatte (1), die Rückplatte (2) und das Stützgerüst (3) aus kohlenstofffaserverstärktem Siliciumcarbid (C/SiC) oder kohlenstoffaserverstärktem Kohlenstoff (C/C) bestehen und keramisch oder mechanisch miteinander verbunden 65 sind und eine monolithische Struktur bilden.

2. Leichtgewichtstrukturen, insbesondere für Meß-, Spann- und- Rearbeitungszwecke, die zwischen einer Frontplatte (1) aus faserverstärkter Keramik und einer Rückplatte (2) aus faserverstürkter Keramik ein mit diesen Platten unverrückbar verbundenes Stützgerüst (3) aus fascrverstärkter Keramik aufweisen, wobei die jeweils für die Platten und das Stützgerüst ausgewählten keramischen Verbundwerkstoffe, vorzugsweise kohlenstoffaserverstärkte Kohlenstoffe (G/C) oder kohlenstoffaserverstärkte Siliciumcarbide (C/SiC), gleiche thermische Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß das faserverstärkte Stützgerüst (3) aus leisten- und/oder platten- und/oder rohrförmigen und/oder T-förmigen und/oder U-förmigen und/oder T-förmigen und/oder Y-förmigen Teilen busteht, die mittels eines Kunstharzes und/oder mechanisch über Schrauben oder Bolzen aus faserverstärkter Keramik unverrückbar untereinander, einen Hohlraum beliebiger Geometric und Größe bildend, verbunden sind und in einem Temperaturprozeß bei Temperaturen von >1405°C unter Sauerstoffausschluß über die Flüssigsiliziertechnik mit Silicium zu einem monolithischen Bauteil zusammensiliziert und somit gefügt wer-

- 3. Leichtgewichtstrukturen nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Prontplatte (1), die Rückplatte (2) und das Stützgerüst (3) jeweils aus einem oder mehreren C/C- und/oder C/SiC-Segmenten im Halbzeug aufgebaut sind und dieses Halbzeug über die Infiltration mit Silicium bei Temperaturen von >1405°C zu einer monolithischen Struktur aus faserverstärkter Keramik, vorzugsweise kohlenstoffaserverstärktem Siliciumcarbid, zusammensiliziert wird.
- 4. Leichtgewichtstrukturen nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Front-(1) und Rückplatte (2) und das Stützgerüst (3) vor der Silizierung aus faserverstärkter Keramik, insbesondere kohlenstoffaserverstärktem Kohlenstoff (C/C) bestehen und durch die Flüssigsilizierung mit Silicium bei Temperaturen zwischen 1400°C und 2100°C zu einem monolithischen Bauteil aus kohlenstoffaserverstärktem Siliciumcarbid (C/SiC) infiltriert und abreagiert werden
- 5. Leichtgewichtstrukturen nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Stützstruktur (3) zwischen- der Front- (1) und Rückplatte (2) aus leisten- und/oder platten- und/oder rohrförmigen und/oder T-förmigen und/oder U-förmigen und/oder T-förmigen und/oder Y-förmigen Teilen besteht, welche in Abhängigkeit von Anzahl, Größe und Abstand zwischen einander entsprechende Hohlräume beliebiger Geometrie zwischen der Front- und Rückplatte ausbilden und somit die Leichtgewichtung der monolithischen Sandwich-Struktur beeinflussen.
- 6. Leichtgewichtstrukturen nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Frontplatte (1) und/oder die Rückplatte (2) auf ihrer der Stützstruktur (3) zugekehrten Oberfläche eine Klebe- oder Sinterschicht aufweist, die aus Phenolharz und/oder Kohlenstoffpulver (Ruß oder Graphit) und/oder Silicium und/oder Siliciumcarbid und/oder Kohlenstoffasern oder einer Mischung daraus gebildet ist, wobei sich die Klebe- oder Sinterschicht bei der thermischen Behandlung mit Flüssigsilizierung zu Siliciumcarbid oder kohlenstoffaserverstärktem Siliciumcarbid umwandelt und somit die gleiche oder eine ähnliche Zusammensetzung und Eigenschaften wie die Front- und Rückplatte oder Stützstruktur aufweist.

7. Verfahren zur Herstellung einer Leichtgewicht-

PAGE 18/22 * RCVD AT 10/5/2005 12:20:17 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-6/25 * DNIS:2738300 * CSID:1 631 549 0404 * DURATION (mm-ss):06-24

8

אצג פטו וטטעב ער

7

struktur nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine Frontplatte (1) aus C/C, eine Rückplatte (2) aus C/C und ein Stützgerüst aus C/C (3) unverrückbar miteinander verbunden werden, dadurch gekennzeichnet, daß zur Bildung des Stützgerüsts (3) 5 zwischen einer Front- (1) und einer Rückplatte (2) leistenformige Teile und/oder plattenformige Teile und/ oder rohrformige und/oder T-förmigen und/oder U-förmigen und/oder T-förmigen und/oder Y-förmigen Teile aus C/C oder C/SiC aufgestellt und die Kontaktslächen 10 mit einem Kunstharz zusammengeklebt und damit das Halbzeug zusammengehalten wird, danach diese Anordnung in einem Ofen unter Aufrechterhaltung einer nicht oxidierenden Atmosphäre auf mindestens die Schmelztemperatur von Silicium (>1405°C) erhitzt, 15 daß Silicium in die Struktur penetriert und zumindest teilweise mit dem angebotenen Kohlenstoff zu Siliciumcarbid abreagiert und nach dem Abkühlen das so erhaltene Stützgerüst (3) mit der Frontplatte (1) und der Rückplatte (2) unverrückbar zu einer monolithischen 20 Leichtgewichtstruktur hoher Steifigkeit bestehend aus kohlenstoffaserverstärktem Siliciumcarbid (C/SiC) verbunden wird.

8. Verfahren zur Herstellung einer hochsteifen Leichtgewichtstruktur nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
zur Infiltration und Reaktion des Halbzeugs bei dem
thermischen Prozeß zur Verfügung gestellte Silicium
als Pulver und/oder als Granulat und/oder als SiliciumPormkörper der Leichtgewichtstruktur von innen und/
oder von außen insbesondere von oben und/oder unten,
angeboten wird.

9. Verfahren zur Herstellung einer hochsteigen Leichtgewichtstruktur nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Leichtgewichtstrukturen aus faserverstärkter Keramik eine kontinuierliche Faserverstärkung aus Geweben und/oder eine Kurzfaserverstärkung und/oder eine Filz bzw. Vliesverstärkung aufweisen und diese Faserverstärkungen vorzugsweise aus Kohlenstoffasern besteht.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

45

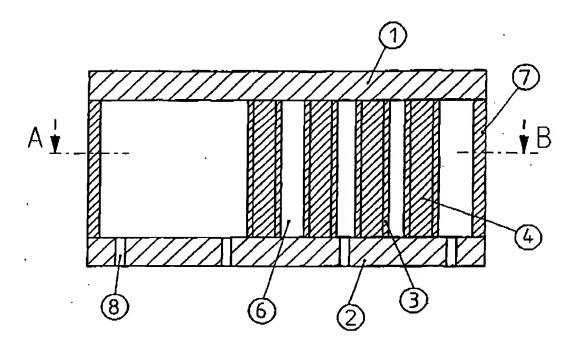
50

55

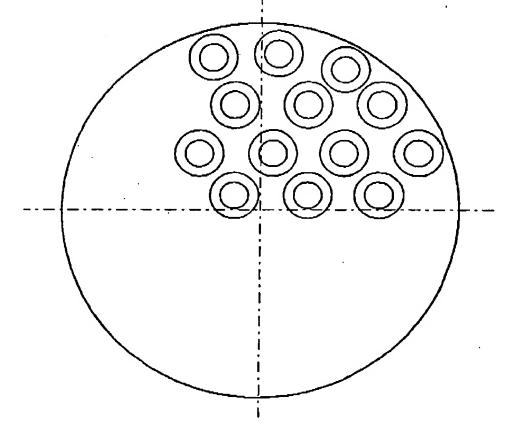
60

65

Int. Cl.7: Offenlegungstag: C 04 B 35/80 9. März 2000



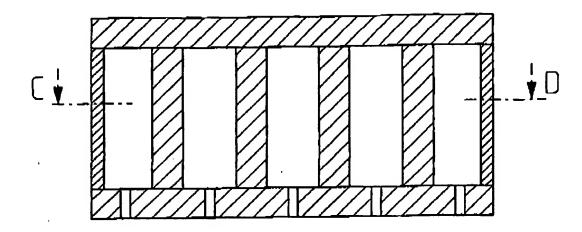




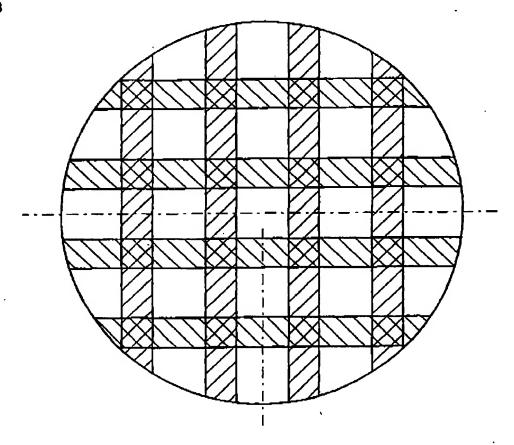
Figur 2

..... Offenlegungstag:

C 04 B 35/80 9. März 2000



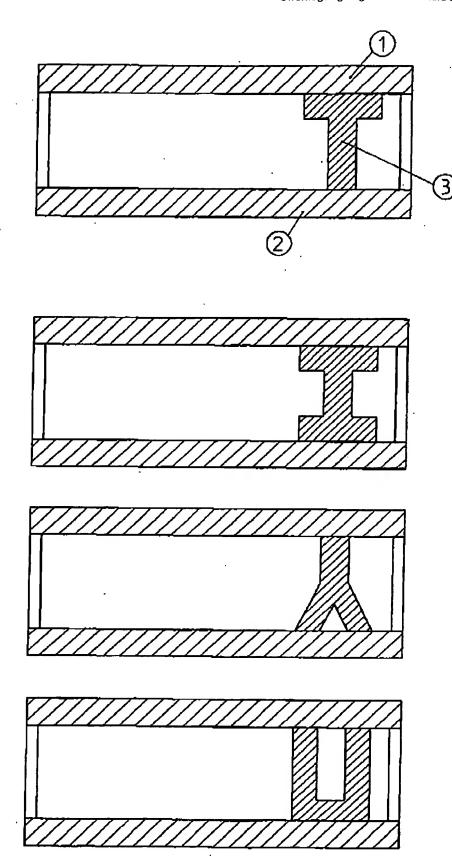
Figur 3



Figur 4

Int. Cl.7: Offenlegungstag:

C 04 B 35/80 9. März 2000



Figur 5